УДК 621.375.82

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЛНОВОДНЫХ КВАНТОВЫХ УСИЛИТЕЛЯХ

м. О. МАНВЕЛЯН, Р. М. МАРТИРОСЯН, Л. Э. АБРАМЯН

Институт радифизики и электроники НАН Армении

(Поступила в редакцию 24 декабря 1993 г.)

Показано, что предельная площадь усиления волноводного квантового усилителя достигается соответствующим выбором длины и концентрации кристаллов в зависимости от потерь в нем.

В последние годы при разработке квантовых усилителей (КУ) предпочтение отдается усилителям волноводного типа (ВКУ) [1—3]. Они технологичны в изготовлении (сечение волновода заполняется активным веществом), обладают широкими полосами перестройки и пропускания, но имеют малое усиление на единицу длины активного вещества. Широкополосность в них достигается линейной расстройкой внешнего магнитного поля, приводящей к неоднородному уширению линии ЭПР.

В настоящей работе на примере рубинового КУ на частоте 22,2 ГГи, при симметричной схеме накачки (Θ =54,7°) исследована возможность получения максимальной площади усиления от каскада ВКУ в заданной полосе частот путем более эффективного использования рабочего вещества и электродинамической системы. Под площадью усиления подразумевается произведение $\Delta F(G^{1/2}-1)$, где ΔF полоса пропускания, G—коэффициент усиления отражательного КУ.

С одной стороны, ВКУ из-за больших длин рабочих кристаллов $(l_h \gg k_B)$ является системой с распределенными параметрами. Расчет усиления последнего осуществляется методами, применяемыми для усилителей бегущей волны, рассматривая стоячую волну в нем как сумму двух противоположно бегущих волн. Коэффициент усиления такой системы (без поправок на линейную расстройку магнитного поля) дается выражением:

$$G_{(AB)} = 2 \cdot 27.3 \frac{sl_k}{O_{mi}}$$
, (1)

где s—коэффициент замедления групповой скорости сигнальной волны в кристалле, Q —магнитная добротность активного вещества:

$$\frac{1}{Q_m} = k \frac{NI}{\Delta_V} \,, \tag{2}$$

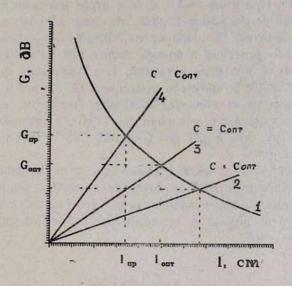
k —постоянная, N —число парамагнитных частиц в см³ вещества. I — коэффициент инверсии, а $\Delta \nu$ —ширина линии сигнального перехода.

С другой стороны, ВКУ это обычный усилитель отражательного типа, без резонансных элементов, обладающий конечными потерями (а). Вследствие этого усиление ВКУ ограничивается следующим выражением:

$$G_{(AII)} = 10 \lg \frac{\alpha}{\alpha - 1}, \tag{3}$$

что не учитывается при разработке усилителей. Потери в основном обусловлены длиной материала и качеством электродинамической системы.

Необходимо отметить, что в КУ обычно применяются кристаллы с оптимальной концентрацией парамагнитной примеси ($C_{\rm ORT}$), при которой значение коэффициента инверсии максимально. Для рубина $C_{\rm ORT} \approx 0.02\%$ Cr^{3+} , а $I \approx 1.8$ при T = 4.6 K для данной схемы накачки.



Зависимость коэффициента усиления ВКУ эт длины образца: 1—по формуле (3); 2—4— по формуле (1) при разных значениях концентрации примеси.

Предполагая линейную зависимость потерь усилителя от длины образца, представим (3) в единицах длины (кривая 1 на рисунке). Тогда для данного ВКУ с оптимальной концентрацией активного вещества существует оптимальная длина (lопт), при которой усиление максимально, что определяется точкой пересечения кривых $G(l_k)$, полученных по формулам (1) и (3). Как видно из рисунка, дальнейшее увеличение коэффициента усиления данного ВКУ возможно лишь при применении образцов с $C > C_{\text{опт}}$, т. е. при низких значениях магнитной добротности Q_m . Однако с увеличением концентрации примеси усиливаются спин-спиновые взаимодействия между парамагнитными частицами, приводя к уширению линии и увеличению скоростей ре-

лаксации между уровнями энергии иона, что в свою очередь приводит к уменьшению коэффициента инверсии. Но названные параметры существенно не ухудшаются при увеличении концентрации ионов в $3\div 4$ раза по сравнению с $C_{\rm ORT}$ [4,5], что дает возможность применения таких образцов в ВКУ. Предельное для данного усилителя усиление ($G_{\rm np}$) достигается соответствующим 'выбором длины (потерь усилителя) и концентрации образца. Предельная концентрация $C_{\rm r}$ для рубина, выше которого его применение в ВКУ не целесообразно, составляет $C_{\rm np} \approx 0.1$ %, при которой начинают доминировать вышеназванные взаимодействия [4].

Для подтверждения сказанного проведены измерения на образцах рубина с $C\approx 0.02\%$, 0.04% и 0.08% Cr^{3+} , согласно которым для образца с $C\approx 0.08\%$ ширина линии увеличивается менее, чем в 1,5 раза, а скорости релаксации—на $12\div 16\%$ по сравнению с образцом C=0.02% Cr^{3+} . При этом $I\approx 1.6$, т. е. в итоге магнитный декремент (2) увеличивается более чем в 2 раза. На этих же образцах реализовано квантовое усиление. На образце с $C\approx 0.02\%$ Cr^{3+} и $l_{*}=10$ см получено 9,2 дБ чистого усиления в полосе частот 240 МГц. Укорачивая длину этого усилителя индиевой вставкой, т. е. уменьшая потери, при $l_{*}=-7.5$ см и $C\approx 0.08\%$ получено усиление 12,6 дБ в той же полосе, при мощности накачки на образце $P\leqslant 80$ мВт. При этом переходы накачки насыщались: изменению усиления на 1 дБ соответствовало 2 дБ накачки. Отметим, что в [2] при $C\approx 0.05\%$ Cr^{3+} и $l_{*}=8.7$ см получено 9,6 дБ усиления.

Таким образом, доказана возможность применения концентрированных кристаллов в ВКУ в качестве активных веществ. Показано также, что предельное усиление таких систем достигается выбором соответствующей длины и концентрации образцов, допускаемых потерями усилителей.

ЛИТЕРАТУРА

- Л. Э. Абрамян, Р. М. Мартиросян, Н. Г. Погосян. Радиотехника и электроника, 24, №1, 191(1979).
- 2. C. R. Moore, P. S. Clauts. IEEE Trans, MTT-27, № 3, 249 (1979).
- 3. S. P. Boughn, E. S. Cheng, D. A. Cottingham, D. I. Fixsen. RSI, 61, № 1, 156 (1990).
- В. Б. Штейншлейгер, Г. С. Мисежников, П. С. Лифанов. Квантовые усилители (мазеры). М., 1971, с. 432.
- М. О. Манвелян, Р. М. Мартиросян. Изв. АН АрмССР, Физика, 23, 231 (1988).

ԱԿՏԻՎ ՆՑՈՒԹԵՐԻ ԱՐԴՑՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱԼԻՔԱՏԱՐԱՑԻՆ ՔՎԱՆՏԱՑԻՆ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՄ

U. 2. UUDADIBUD, A. U. UUPSPPAUBUD, L. L. UPPUZUUBUD

տագործման Տնարավորությունը ալիջատարային քվանտային ուժեղացուցիչներում։ Ցույց է

արված, որ այդպիսի սարքերում սահմանային ուժեղացման մակերես կարելի է ստանալ հաժապատասխան երկարության և կոնցենտրացիայի նմուշի ընտրությամբ, կա¦ւված ուժեղացուցիչի կորուստներից։

ACTIVE MATERIALS UTILIZATION EFFICIENCY IN THE WAVEGUIDE QUANTUM AMPLIFIERS

M. O. MANVELYAN, R. M. MARTIROSYAN, L. E. ABRAHAMYAN

We have proved experimentally the possibility of high-concentration paramagnetic crystals utilization as active materials in the waveguide quantum amplifiers. The largest gain area of such systems is shown to be attained by a corresponding selection of samples length and concentration, depending on operation losses in the amplifier.